11 特許出願公告

⑫特 許 公 報(B2)

昭62-60914

⑤Int Cl.*

識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 昭和62年(1987)12月18日

H 02 M 7/10

A = 6650 - 5H

発明の数 1 (全5頁)

公発明の名称 直流高電圧発生装置

> の特 顧 昭55-139352

❸公 開 昭57-65272

❷出 関 昭55(1980)10月7日 ❷昭57(1982)4月20日

年 弘 砂発 明 者 野村 川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機製造株式会社内

⑪出 願 人 富士電機株式会社 川崎市川崎区田辺新田1番1号

20代 理 人 弁理士 浜田 治雄 外1名

審 杳 官 平岡

66参考文献 英国特許1090995 (GB, A)

1

ᡚ特許請求の範囲

1 高周波電源にトランスを接続し、このトラン スの出力巻線を複数の分割巻線で構成して各分割 巻線に整流回路を接続し、これらの整流回路を直 流出力側で互いに直列接続して直流高電圧力を得 5 接続した平滑コンデンサC₂~C₅を介して高圧直 る装置において、

トランスの出力巻線は简形多相巻線として構成 されていて、且つ各分割巻線は複数個の単一の巻 線層からなり、

直列接続されていて、

各分割巻線に属する個々の単一の巻線層は、異 なる分割巻線に属する単一の巻線層に隣接するよ うに配置されており、

れが属している分割巻線は、直流出力側を直接的 に接続されている隣同士の整流回路にそれぞれ対 応した分割巻線であること

を特徴とする直流高電圧発生装置。

発明の詳細な説明

この発明は、高周波電源に高周波トランスを介 して高圧高速整流ダイオードからなる整流回路を 接続し、直流の高電圧を発生する装置に関するも のである。

1図に示すように、高周波電源10に高圧高周波 トランス12の一次巻線W.を接続すると共に高 圧髙周波トランス12に2次から5次の分割巻線

W₂~Wsを設け、これら高圧高周波トランス12 の2次から5次の分割巻線W2~W5をダイオード 整流ブリツジ14に接続し、このダイオード整流 ブリッジ14の出力を各分割巻線W2~Wsと並列 流電力を出力するようにしたものが知られてい る。なお、参照符号16は高圧負荷を示す。

このように構成された従来の直流高電圧発生装 置においては、髙周波トランス12の2次から5 同じ分割巻線に属する単一の巻線層は電気的に 10 次の高圧出力分割巻線W2~W5の層内にストレー キャパシタンス(漂遊容量)SC2~SCsが存在 し、このストレーキヤパシタンスSCa〜SCsにお ける充放電エネルギーまたは電流が大きくなり、 小容量の機種では効率の面で大きな問題となる。 しかも、互いに隣接する単一の巻線層のそれぞ 15 また、従来装置においては、前記分割巻線につ き、隣接する巻線層間のキャパシタンスが大きい **简形巻線の使用は好ましくなく、円板巻線(ディ** スクコイル)を鉄心の軸方向に複数個配置してス トレーキヤパシタンスSCを小さくする構成が一 20 般的であつた。しかしながら、円板巻線は、製作 技術上巻線の占積率が低いため、高周波トランス

そこで、本発明者は、前述した従来の直流高電 圧発生装置の問題点を全て克服すべく種々検討を 従来の直流高電圧発生装置としては、例えば第 25 重ねた結果、高圧高周波トランスの出力巻線を簡 形多層巻線とし、各分割巻線における個々の巻線 層は、互いに異なる分割巻線に所属する巻線層が

隣接するように配置することにより、ストレーキ

の小型化に限界があつた。

ヤパシタンスを異なる分割巻線間に存在させるこ とができ、しかも異なる分割巻線間には交流電圧 が印加されることがないため、これらストレーキ ヤパシタンスによる無効電力の発生を防止し、前 記問題点を一挙に解消し得ることを突き止めた。

従つて、本発明の目的は、巻線の占積率が高い 筒形巻線を使用してストレーキャパシタンスによ る弊害を除去し、小型化し得る高圧高周波トラン スを使用した直流高電圧発生装置を提供するにあ

前記目的を達成するため、本発明においては、 トランスの出力巻線は筒形多相巻線として構成さ れていて、且つ各分割巻線は複数個の単一の巻線 層からなり、同じ分割巻線に属する単一の巻線層 は電気的に直列接続されていて、各分割巻線に属 15 おいては互いに異なる分割巻線の巻線層が隣接す する個々の単一の巻線層は、異なる分割巻線に属 する単一の巻線層に隣接するように配置されてお り、しかも、互いに隣接する単一の巻線層のそれ ぞれが属している分割巻線は、直流出力側を直接 的に接続されている隣同士の整流回路にそれぞれ 20 W₂もしくはW₂→W₃→W₄→W₅とすべきである。 対応した分割巻線であることを特徴とする。

前記の直流高電圧発生装置において、各分割巻 線は、ダイオードを介して直列接続しそれぞれダ イオードを共用するダイオード整流ブリツジを構 成することにより、グイオードの使用個数を減ら 25 グループが $W_2 o W_3 o W_4 o W_5$ の順序になつてい すことができる。

また、各分割巻線は、それぞれダイオードを介 して直列接続し半波整流回路を構成すると共に両 出力端のダイオードと分割巻線との間にそれぞれ 補助コンデンサを付設し、これら補助コンデンサ 30 零であるが左端ではW₂の分担電圧の1/3の値にな と各分割巻線間のストレーキャパシタンスを平滑 コンデンサとして作用させることができる。

さらに、直列接続された分割巻線の両端間に平 滑コンデンサを接続し、平滑コンデンサの使用個 数を減らすことができる。

次に、本発明に係る直流高電圧発生装置の実施 例につき添付図面を参照しながら以下詳細に説明 する。なお、説明の便宜上第1図に示す直流高電 圧発生装置と同一の構成部分については同一の参 照符号を使用して説明する。

第2図は、本発明に係る直流高電圧発生装置に おける高圧高周波トランス12の巻線の構成を示 すものである。すなわち、本発明においては、高 圧出力分割巻線W₂~W₅につき1層毎に巻線端U₂

~U₅, V₂~V₅を開放して配置し、その後各巻線 端の相互間と接続し、隣接層の巻線₩₂~₩₅をそ れぞれ第1図に示すように接続配置する。

この図によれば、鉄心とともに樹脂モールドす 5 ることのできる筒形多層巻線構造を有する巻線体 は、層数13を有し、内側の1番目から12番目ま での層に分割巻線W₂~W₄が含まれ、13番目の層 (最外層)として1次巻線W₁が配置されている。 各分割巻線W₂~W。はそれぞれ3つの巻線層を有 10 する。1番目から4番目までの層が第1グループ を、5番目から8番目までの層が第2グループ を、そして9番目から12番目までの層が第3グル ープを構成していて、各グループには各分割巻線 の巻線層が1つずつ含まれている。各グループに ることになる。各グループ内において、互いに隣 接する2つの巻線層の間の電圧を等しくするに は、各巻線層の順序は第1図に示す分割巻線の直 列接続関係の順序にあわせて、₩₅→₩₄→₩₃→ しかも隣り合うグループ同士ではその順序が逆に なるようにするのがグループ間の電圧差を小さく することができる。図示の例では第1グループが W₅→W₄→W₃→W₂の順序であるのに対して第2 る。この場合第1グループと第2グループとの間 では、W2の第1グループに属する巻線層と同じ くW₂の第2グループに属する巻線層が隣り合う ことになり、両巻線層間の電圧差は図の右端では り、その途中では直線的に変化する。したがつ て、両巻線層は平行配置として図示されている が、絶縁上の観点では右端側では近接し、左端側 では広がつているような間隔で配置するとよい。 35 第2グループと第3グループとの間についても同 様である。

巻線機を使用した製造過程では、4番目の層か ら5番目の層に移るときと8番目の層から9番目 の層へ移るときとを除いて、巻線層の終端毎に導 40 線が一旦切断される。巻線工程終了後にそれらの 切断点は対応する分割巻線に属する次の巻線層の 導線始端と接続される。

このように、高圧高周波トランス12の分割巻 線を構成することにより、巻線W₂の巻線層であ

る4層と5層間、巻線Ws巻線層である8層と9 層間におけるストレーキャパシタンスは問題にな るが、他の層間のストレーキャパシタンスは第3 図に示すようなストレーキャパシタンスSC23, SC34, SC45となり、全く無効電力の対象となら 5 なくなる。この場合、前記のストレーキャパシタ ンスが問題となる2つの層間は、絶縁を厚くする ことによりストレーキャパシタンスを減じること ができ、実用的には問題とならない。

SOar, SCaが問題にならなくなる理由は次の通 りである。第2図において、巻線端U₂からV₂に 至る巻線Waに発生する起動力と、この巻線Waに 沿つて巻線端U₃からV₃に至る巻線W₃に発生する 起電力は全く同一であるため、両巻線W2, W3間 15 の層間には交流の誘起電圧は全く印加されなくな る。同様にして、巻線端U、からV、に至る巻線W、 と巻線端UsからVsに至る巻線Wsの全ての層間に も交流電圧は印加されない。そして、各巻線の層 つて出力される直流電圧相当分が印加されるのみ で、交流電圧は印加されない。このような理由に 基づいて、前記ストレーキャパシタンスSCzz。 SC31、SC13の存在は、無効電力の対象とはなら なくなるのである。すなわち、本発明において 25 は、ストレーキャパシタンスが、第3図に示され るように、非常に好ましい分割巻線間ストレーキ ヤパシクンスとすることができることが特徴であ る。因みに、従来の茼形巻線においては、1つの めるため、普通一層で済むことはなく、分割巻線 内のストレーキャパシタンスが非常に大きくなる という欠点がある。

前述したところから明らかなように、本発明に 圧巻線におけるストレーキャパシタンスが第3図 に示されるように位置し、これによりダイオード 整流ブリッジ 1 4 を構成する各ダイオードDの電 圧分担が明確となるため、第1図に示す従来装置 のように平滑コンデンサを分割して接続すること 40 なく、単一の平滑コンデンサC」で構成すること ができる。

また、平滑コンデンサCiを分割しないでよい ことと、ダイオード整流ブリッジ14を構成する

各ダイオードDの電圧分担が明確になることか ら、第3図に示すように、整流ダイオードDの使 用個数を減らした回路構成とすることが可能とな

6

さらに、本発明装置によれば、前記のように整 流ダイオードDの電圧分担が明確になることか ら、第4図に示すように、整流ダイオードDを半 波整流回路として構成することができる。この場 合、ストレーキャパシタンスSC22, SC34, SC45 そこで、前記ストレーキャパシタンスSCaa, 10 は平滑コンデンサの一部として作用させることが できるため、補助コンデンサC12,Cseを追加する と共にこれらのキヤパシタンスを大きくすること により、平滑コンデンサCのキャパシタンスを小 さくすることができる利点がある。

さらにまた、本発明において使用する高圧高周 波トランスの分割巻線の層間には、直流電圧のみ 印加されるため、コロナ放電による絶縁劣化が殆 んど無くなり、層間絶縁は極く薄いシートで充分 となる。この結果、巻線導体の占積率を向上する 間には、それぞれ各巻線と整流ダイオードDによ 20 ことができると共に好ましいストレーキャパシタ ンスを増加することも可能となる。また、絶縁層 を薄くできることから、巻線全体の熱伝導が良好 となり、高圧高周波トランスの温度上昇を有効に 防止することができる。

前述した実施例から明らかなように、本発明装 置は、高圧高周波トランスにおいて、分割巻線内 のストレーキヤパシタンスを極小にし、分割巻線 間のストレーキャバシタンスを好ましい値に設定 することができる。このため、分割巻線の電圧分 分割巻線を巻き終つてから次の分割巻線を巻き始 30 担が明確となり、平滑コンデンサや整流ダイオー ドの使用個数を減らして回路を簡略化することが できる。また、ストレーキャパシタンスを平滑コ ンデンサの一部として作用させ、平滑コンデンサ のキャパシタンスを小さくすることができる。さ おいては、使用する高圧高周波トランス12の高 35 らに、コロナ放電の心配がなくなり、層間絶縁を 薄くできることから、導体の占積率が向上し、好 ましいストレーキヤパシタンスの増加と放熱効果 を良好にして、高圧高周波トランスの小型化が容 易となる等多くの利点を有する。

> 以上、本発明の好適な実施例について説明した が、本発明の精神を逸脱しない範囲内において 種々の設計変更をなし得ることは勿論である。

図面の簡単な説明

第1図は従来の直流高電圧発生装置の回路図、

8

第2図は本発明に係る直流高電圧発生装置に使用する高圧高周波トランスの高圧巻線の構成配置図、第3図は本発明装置の一実施例を示す回路図、第4図は本発明装置の別の実施例を示す回路図である。

10……高周波電源、12……高圧高周波トラ

ンス、 1 4 ……ダイオード整流ブリッジ、16 … …高圧負荷、SC₂₃, SC₃₄, SC₄₅ ……ストレーキ ヤバシタンス、C₁ ~ C₅ ……平滑コンデンサ、D ……ダイオード、C₁₂, C₅₆ ……補助コンデンサ、 5 W₁ …… 1 次巻線、W₂ ~ W₅ ……分割巻線。







